



2SA1357 (3CA1357)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于闪光灯闪光驱动, 音频功率放大。

Purpose: Strobe flash applications, audio power amplifier applications.

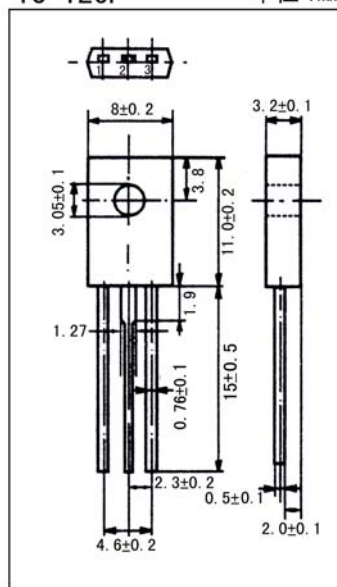
特点: 高 I_C , 低 $V_{CE(sat)}$ 。

Features: High I_C , low $V_{CE(sat)}$.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-35	V
V_{CEO}	-20	V
V_{EBO}	-8.0	V
I_C	-5.0	A
I_{CP}	-8.0	A
I_B	-1.0	A
P_C	1.5	W
$P_C(T_c=25^\circ\text{C})$	10	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

T0-126F 单位: mm



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CEO}	$I_C=-10\text{mA}$	$I_B=0$	-20			V
I_{CBO}	$V_{CB}=-35\text{V}$	$I_E=0$			-100	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-8.0\text{V}$	$I_C=0$			-100	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$	100		320	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-4.0\text{A}$	70			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-4.0\text{A}$	$I_B=-0.1\text{A}$			-1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-4.0\text{A}$			-1.5	V
f_T	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$		170		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$	$I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		62		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: 0:100~200 Y:160~320

